PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

55-003688

(43)Date of publication of application: 11.01.1980

(51)Int.CI.

H01S 3/18 // G02B 5/14

(21)Application number: 53-076879

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

23.06.1978

(72)Inventor:

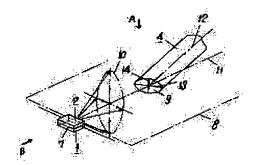
KURATA NOBORU

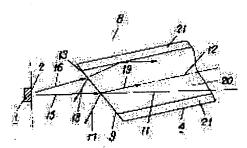
TSUTSUIZUMI TAKASHI

(54) METHOD OF COUPLING SEMICONDUCTOR LASER AND PHOTO-FIBER

PURPOSE: To reduce noises in laser output without damaging the efficiency of coupling, and to stabilize luminescence, by positioning a long axis of a tilt, incident end surface of a photo-fiber on a junction surface of a laser, and by disposing a short axis in a vertical shape to the long axis.

CONSTITUTION: An axis 12 is tilted to a base line 11 so that rays on the base line 11 from a laser 1 be projected to an end surface 9, be refracted and advance in a fiber 4 along the axis 12. A luminous angle of the stripe type semiconductor laser 1 is small on a junction surface 8 and large in the direction vertical to the surface 8, and the laser has oval luminous distribution. When a long axis of an incident end surface is located on the surface 8, a short axis 14 is vertically arranged to the surface 8 and the fiber axis 12 is tilted to the base line 11 on the surface 8, an end surface of the fiber forms oval when viewing from the luminous surface side and agrees with the luminous distribution 10, and the efficiency of coupling is hardly lost. The end surface 9 inclines to the base line 11, the reflected rays of the end surface 9 do not return to a luminous surface 2, noises in output rays are little and luminous action is stable.





LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

That We want of AL MALIBRE Late of Children

STORES OF SECTION SECTION ·斯特·亚克科·马克 医黑心痛节节 人民经营工会会

I DE LA COMMINA LA LA LA LA COLONIO DE DESCRICADO DE CONTRARA DE COMPANSA DE CONTRARA DE C

3 July 1 1 in a restriction of the second contraction of the The set of the second of the second of the second and the second reservoir services and the contraction of the contracti in the formation of the property of the contract of the contra

SERVICE OF THE CONTRACT STREET, AND CONTRACT OF THE CONTRACT O 经过的现在分词 计可控制 加入斯特克斯 人名英格兰 化二十二烯十二十二烷烷 and a color of the article of the company of the property of the color and the state of t in Control (Co. Control dentities & augmentation condens the gradies). n de la companya de l and the common and the contract of the second of the secon some and the state of The stand of the contract of the standard of t

alan 18 Jan 19.

English to treat each start as the all the

Der geführte sollar und einem male eine eine eine mit geführe mit geführe. Die

Control of the state capacity are properly as a section of the sample

in meda jet pež svitan nube, ogga su i salogija in nojvijni,

brownship is recovered to the end to

Pacent in ident

Problembaga. No aresis

and a series of a construction of memory and according to the construction of the construction of

CHOICE CONDITIONS OF THE BAR TERRITORIES OF STORY OF STORY OF STORY

di dioam

Dog, to but suppose being

THIS PAGE BLANK (USPTO)

② 公開特許公報 (A) 昭55—3688

60 Int. Cl.³ H 01 S 3/18 // G 02 B

識別記号

庁内整理番号 7377-5F 7529—2H

⑥公開 昭和55年(1980)1月11日

発明の数 1 to the second of 。 (1844) 一**審查請求。未請求** (1864) 2

(全 3 頁)

ᡚ半導体レーザと光ファイバの結合方法

②特 :

昭53—76879

掛きらま しゅ

❷出

昭53(1978) 6 月23日

⑫発 明 者 倉田昇

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

1.8 2

@発 明 者 简泉堯

1.命运公司阿親王 (斯爾尔)

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

砂代 理 人 弁理士 中尾敏男

.

5 4 7 5 W ·\$100 中国 100 中国 140 中国

1、発明の名称

;:;

半導体ジーザと先ファイバの結合方法

2、特許請求の範囲。 つい こうしゅう

(1) 半導体レーザの発光面に結合する光ファイバ・ の入射端面を、該光ファイバの軸に対して斜めと . し、鼓入射端面の長軸が、前記半導体レーザの接 合面と同一面上にあり、該入射端面の短軸が、該 接合面に対し垂直となるように配置すると共に、 **畝接合面と同一面上において、前配半導体レーザ** の発光面に垂直な方向に対し、前配光ファイバ軸 を傾けたことを特徴とする半導体レーザと光ファ マイベの結合方法o sale Ala

□(2) 一光ファイバ軸は、斜めの入射端面より入射す る、前記半導体レーザの発光面の中心から発する 発光面に垂直を光が、前記光ファイベ内で、光フ フィス軸にほとんど沿って進行するように眩光フ ティバ 軸を前記発光面に垂直を光の方向に対して 傾けたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記 軟の半導体レーザと光ファイバの結合方法o

3、発明の詳細な説明

本発明は光の結合に関し、特に半導体レーザと 光ファイスを結合するにあたり半導体レーザの安 定した発光動作が得られる方法を提供するととを 目的とする。 100

。従来の半導体レーザと光ファイバとの結合方法 を第1図に示す。半導体レーザ1の発光面でから 3出射した光3は3光ファイズ4の入射機画気に入 射する。この時、半導体レーザーから出射した光 のうち、光ファイバタに入射する光の割合、すな カち結合効率は、主に光ファイバの開口数(N.A.) と、半導体レーザの発光分布で決まる。ところで 半導体レーザ1から出射した光3が光ファイバ4 へ入射する際、一部の光が入射端面 5 で反射し、 反射光日となって、発光面2にもどる。今、この 結合効率が小さい場合には反射光らも無視できる が、結合効率が大きい場合は発光面2にもどる反 射光6の割合も大きくなり、その結果、半導体レ - ザの出力光中に無視できない雑音が現われ、発 光動作が不安定となる欠点があった。

1:1

Ξ,

Z. ...

本発明は上記で述べた欠点を解決した半導体レ ーザと光ファイベの結合方法を提供するものでそ の一実施例の構成を第2図に示す。 なお以下の脱 明において、図面中に示す同一番号は同一部分を 示している。 5 - 141

第2図において、1はストライプ形半導体レー ザ、2は発光面、7は接合面、8は接合面を含む - 接合平面、10は半導体レーザ1の発光分布、11 は発光面2の中心に立てた発光面2に垂直を直線 で接合平面B内にある基線、4は光ファイバ、12 は光ファイバ軸、で基礎11に対して傾いており、 8は光ファイバ触1.2に対して斜めな入射端面で ある。ことで、半導体レーザ1 に対して光ファイ - パチは、次の関係になるように配慮されている。 すなわち、斜めな入射端面8の長軸13が接合平 面8上にあり、短軸14が接合平面8に垂直とな るように配置されると共に、半導体レーザ1から 出射した基線上の光が、入射端面8に入射し屈折、 した袋に、光ファイパ軸12に沿って光ファイバ 4内を進むように、光ファイパ軸12を基線11

化対し傾けて配置している。

※第3図および第4図は上記の構成の要部を示し、 これを用いてさらに説明する。 第3図はA方向か ら見た接合平面B上の半導体レーザ1 および光フ ァイバ4を示したものである。 ここで20はコブ 部、21はクラッド部である。光ファイバ軸12 化斜めな入射端面のは、 基線11亿対しても斜め に配置されているため、光ファイバ4内に入射で きる角度で発光面2を出射した光15,16の内、 入射端面ので反射した光17,18位、再び発光 面2にもどることはない。 入射端面 9 で反射しな い光1日は、入射端面日で屈折して光ファイバ4 内に入る。この時、発光面2から出射した光の大 部分を光ファイバ4内に入射させるために、基線 11に沿って入射端面9に入射した光15が、屈 折した後、光ファイバ軸と一致して進むよう(入 射光19)に光ファイバ軸12を基線11に対し て傾けている。

第4図は発光面2の後側(B方向)より光ファ イバ端面8を見た凶である。ととで10は半導体

レーザ1の代表的な発光分布を示す。一般にスト ライブ形半導体レーザの発光角度は、接合平面B 上で小さく、接合平面8に垂直な方向に大きいの で、発光分布10は楕円形をしている。ととろで、 第3図の説明で述べたように、光ファイバ軸12 を基線11に対して傾ける場合は、入射端面Bの 長軸13を接合平面8上に置き、短軸14を接合 平面8に垂直となるように配置して光ファイバ軸 12を接合平面8上で基線11に対して傾けると、 第4図からもわかるように、発光面側から見た光 ファイバ幽面の形状が楕円形を示す。それ故発光 分布10の形状とほとんど一致させることができ るので前述の結合効率の損失はほとんどない。

本実施例によれば、光ファイバ端面日を光ファ イバ軸12および基線11 化対して斜めにすると ともに、基線11に沿って入射端面9に入射した 光が屈折した後に光ファイバ軸12に沿って進み、 さらに、半導体レーザ1の発光分布1つの形状と、 発光面2から見た光ファイバの入射端面9の形状 をほとんど一致させるように光ファイバ4を基線

11に対して傾けたことにより、特にストライプ 形半導体レーサと光ファイバを結合する方法にお 化弹簧铁 安全制度

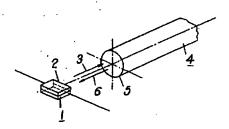
- 1) 光ファイバの入射端面 9 での反射光が発光: 面2にもどらないので、半導体レーザ1の出力 光中の雑音が少なく、安定した動作を行たう。
- i) 半導体レーザ1の発光分布10に合わせて、 光ファイバ4を配置することにより、結合効率 の損失はほとんどない。
- という使れた効果を奏する。 ・ ・ ・ ・ ・ こ

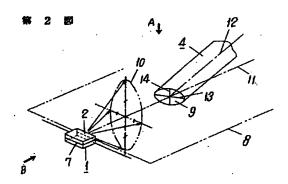
- 以上のように本発明は、半導体レーザと光ファ イバを結合するにあたり、結合効率を損なりこと なく、半導体レーザの出力光中の雑音を散滅させ 、発光動作を安定とする工業的にも優れた結合方法 ⇔を提供するものである。

4、図面の簡単な説明、アースは、これにありませる。

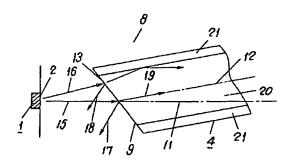
第1 図は従来の結合方法を説明する斜視図、第 2図は本発明の結合方法の一実施例を示す斜視図、 第3図は本実施例の要部を説明する上面図、第4 図は本典施例の要部を説明する正面図であるo

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名





第 3 図



第 4 図

